

A theoretically accurate mobility model for semiconductor device drift-diffusion simulation

Velmre, Enn; Udal, Andres; Kocsis, T.; Masszi, F. Physica scripta 1994 / p. 263-267 <https://doi.org/10.1088/0031-8949/1994/T54/064>

Ab initio study of GaN properties using VASP software package

Klopov, Mihhail; Kuusk, Ahto; **Velmre, Enn; Udal, Andres** BEC 2004 : proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-6, 2004, Tallinn, Estonia 2004 / p. 55-58 : ill

Advances in terahertz technology with emphasis on quantum cascade lasers

Reeder, Reeno; Velmre, Enn; Udal, Andres Elektronika ir elektrotehnika = Electronics and electrical engineering 2010 / 8, p. 47-50 <https://eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/9225>

Ambipolar diffusion in a three-carrier semiconductor plasma

Velmre, Enn; Masszi, F. Program of 17th Nordic Semiconductor Meeting, Trondheim, Norway, June 17-20, 1996 1996 / p. 36

Apparent decrease of diffusion coefficients due to the plasma-induced band gap narrowing

Udal, Andres; Velmre, Enn 19th Nordic Semiconductor Meeting : May 20-23, 2001, Copenhagen, Denmark : abstracts 2001 / p. 22 : ill

A brief survey of exciton concentration models for Si

Velmre, Enn; Udal, Andres The 7th Biennial Conference on Electronics and Microsystem Technology "Baltic Electronics Conference" : BEC 2000 : October 8 - 11, 2000, Tallinn, Estonia : conference proceedings 2000 / p. 19-22 : ill

[Christou, A. Integrating reliability into microelectronics manufacturing. Series on design and measurement in electronic engineering, edited by D.V.Morgan and H.L.Grubin. Wiley, Chichester, 1994. 349 p. : Book review]

Velmre, Enn Engineering applications of artificial intelligence 1996 / p. 97 https://www.ester.ee/record=b1200126*est

Comparison of methods for solving the Schrödinger equation for multiquantum well heterostructure applications

Udal, Andres; Reeder, Reeno; Velmre, Enn; Harrison, Paul Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2006 / 3-2, p. 246-261 : ill

Comparison of photon recycling effect in GaAs and GaN structures

Velmre, Enn; Udal, Andres Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2004 / 3, p. 157-172

Comparison of Si and SiC devices surge current capability by means of numerical simulations

Velmre, Enn; Udal, Andres BEC'96 : the 5th Biennial Baltic Electronics Conference, October 7-11, 1996, Tallinn, Estonia : proceedings 1996 / p. 77-80: ill

Comparison of uncertainty relations in quantum mechanics and signal processing

Udal, Andres; Kuk, Vello; Velmre, Enn; Klopov, Mihhail 11th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations and 4th Feynman Festival : Olomouc, Czech Republic, June 22-26, 2009 2009 / p. 154

Comparison of uncertainty relations in quantum mechanics and signal processing [Electronic resource]

Udal, Andres; Kuk, Vello; Velmre, Enn; Klopov, Mihhail 11th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations and 4th Feynman Festival : Olomouc, Czech Republic, June 22-26, 2009 : conference proceedings 2009 / [16] p. [DVD]

Computer-aided analysis of the GTO thyristor current squeezing effect

Velmre, Enn; Udal, Andres Automation, simulation & measurement : ASM'91 : 3rd biennial conference, Tallinn, October 7-11, 1991. Section S / Tallinn Technical University 1992 / p. 159-171: ill

Corrected accounting of electron-hole scattering in cross-term current equations for Si and SiC

Velmre, Enn; Udal, Andres 18th Nordic Semiconductor Meeting, Linköping, June 7-10, 1998 : abstracts 1998 / p. F-88: ill <https://iopscience.iop.org/article/10.1238/Physica.Topical.079a00193>

Corrected accounting of electron-hole scattering in cross-term current equations for Si and SiC

Velmre, Enn; Udal, Andres Physica scripta 1999 / Proceedings of 18th Nordic Semiconductor Meeting, Linköping, Sweden, June 7-10, 1998, ISBN 91-87308-71-1, p. 193-197: ill <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999PhST...79..193V/abstract>

Critical analysis of uncertainty relations based on signal duration and spectrum width

Udal, Andres; Kuk, Vello; Velmre, Enn Elektronika ir elektrotehnika = Electronics and electrical engineering 2009 / 6, p. 31-34 : ill

Department of Electronics

Min, Mart; Parve, Toomas; Laansoo, Ants; Männama, Vello; Velmre, Enn; Udal, Andres Research activities / Tallinn Technical University 1993 / p. 79-81 https://www.ester.ee/record=b1053754*est

Development and optimisation of modelling methods and algorithms for terahertz range radiation sources based on quantum well heterostructures = Kvantaukudega heterostruktuuridel põhinevate terahertsikiirgurite modelleerimismeetodite ja -algoritmide arendus ja optimeerimine

Reeder, Reeno 2014 https://www.ester.ee/record=b3084247*est

Development of numerical semiconductor device models and their application in device theory and design

Udal, Andres 1998 http://www.ester.ee/record=b1158907*est

Development of quantum cascade laser simulation software

Udal, Andres; Reeder, Reeno; Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; Velmre, Enn BEC 2012 : 2012 13th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 13th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-5, 2012, Tallinn, Estonia 2012 / p. 47-48 : ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Discussion of the development aspects of the quantum cascadelaser simulation software

Reeder, Reeno; Udal, Andres; Velmre, Enn International Conference on THz and Mid Infrared Radiation and Applications to Cancer Detection Using Laser Imaging : workgroup meetings of Cost Actions MP1204 and BM1205 : October 10-11, 2013, Sheffield Hallam University, United Kingdom 2013 / p. [36]

Eesti kingitus maailma füüsikale : 9. aprillil möödus 237 aastat Thomas Johann Seebecki sünnist Tallinnas : [intervjuu prof. Enn Velmre ja prof. Mart Min'iga]

Velmre, Enn; Min, Mart; Ummelas, Mart Mente et Manu 2007 / 18. apr., lk. 3 : ill https://www.ester.ee/record=b1242496*est

Efficiency estimation for a broadband 7 THz radiation source with GaAs/AlGaAs parabolic quantum wells

Reeder, Reeno; Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; Udal, Andres; Velmre, Enn The proceedings of the Ninth International Conference on Intersubband Transitions in Quantum Wells : Ambleside, Cumbria, U.K., 9-14th September 2007 2007 / p. P67-2 https://www.academia.edu/63544688/Efficiency_Estimation_for_a_Broadband_7_THz_Radiation_Source_with_GaAs_AlGaAs_Parabolic_Quantum_Wells

Electrothermal simulation of power semiconductor devices

Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres Proceedings of the 1991 International Workshop on VLSI Process and Device Modeling, 26-27 May, 1991, Oiso, Kanagawa, Japan 1991 / p. 28-29

Electro-thermal simulations and forward surge current failure prediction for SiC diodes

Velmre, Enn; Udal, Andres Program of 17th Nordic Semiconductor Meeting, Trondheim, Norway, June 17-20, 1996 1996 / p. 28

Elektroonika desintegratsioon

Velmre, Enn Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2002 2003 / lk. 33-38

The experimental results of reverse recovery effects in power fastrecovery diodes analyzed by numerical model

Velmre, Enn; Udal, Andres; Vaher, G.T.; Tarma, Mati Proceedings International AEGEAN Conference on Electrical Machines and Power Electronics, Kusadasi 27-29 May, 1992 1992 / p. 738-743: fig

Failure prediction of power devices under reverse surge current conditions

Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres ISPSD'92 : Proceedings of the 4th International Symposium on Power Semiconductor Devices & Ics, Waseda University, Tokyo, Japan, 19-21 May 1992 1992 / p. 118-123: fig <https://doi.org/10.1109/ISPSD.1992.991247>

40 years of Electronics Department at Tallinn Technical University

Tamm, Uljas; Velmre, Enn BEC 2002 : proceedings of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference : October 6-9, 2002, Tallinn, Estonia 2002 / p. 7-10

GIGA - power semiconductor devices simulation software

Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres The Bug Exterminator (USA). Special issue, Santa Clara 1990 / Dec., p. 1-16: fig

High phonon-drag thermoelectric efficiency of SiC at low temperatures

Velmre, Enn; Udal, Andres; Grivickas, V. Final program of the 10th International Conference on SiC and Related Materials : ICSCRM'2003 : Lyon, France, Oct. 5-10, 2003 2003 / p. ThP4-13 https://www.researchgate.net/publication/240834700_High_Phonon-Drag_Thermoelectric_Efficiency_of_SiC_at_Low_Temperatures

Impact of phonon drag effect on seebeck coefficient in p-6H-SiC : experiment and simulation

Bikbajevs, V.; Velmre, Enn; Udal, Andres Material science forum 2003 / p. 407-410 <https://www.scientific.net/MSF.433-436.407>

Impact of phonon-drag effect on seebeck coefficient in SiC : experiment and simulation

Bikbajevs, V.; Grivickas, V.; Stölzer, M.; Velmre, Enn; Udal, Andres Abstracts of the Lithuanian National Physics Conference : LNPK-34 : Vilnius, 2003 2003 / p. 219 <http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A269444&dswid=8596>

Influence of excitonic scattering on charge carrier ambipolar diffusion in silicon

Udal, Andres; Velmre, Enn ESSDERC'97 : proceedings of the 27th European Solid-State Device Research Conference, Stuttgart, Germany, 22-24 September 1997 / p. 212-215: ill <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1503333>
<https://doi.org/10.1109/ESSDERC.1997.194403>

Infotehnoloogia teaduskond

Gordon, Boris; Velmre, Enn; Einer, Lauri; Tamm, Uljas; Meister, Ants; Korsen, Viljo; Märten, Olev; Parve, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes; Min, Mart Leiutajaid ja leiutisi Tallinna Tehnikaülikoolis 1922-2007 2008 / lk. 34-47 : ill
https://www.ester.ee/record=b2412718*est

Investigation of charge carrier lifetime temperature-dependence in 4H-SiC diodes

Velmre, Enn; Udal, Andres Silicon carbide and related materials 2006 2007 / p. 375-378
https://www.researchgate.net/publication/250348987_Investigation_of_Charge_Carrier_Lifetime_Temperature-Dependence_in_4H-SiC_Diodes

Investigation of silicon carbide diode structures via numerical simulations including anisotropic effects

Velmre, Enn; Udal, Andres; Masszi, F.; Nordlander, E. Simulation of semiconductor devices and processes. Vol. 6 1995 / p. 340-343: ill https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7091-6619-2_83

Jaapani professor esines Tallinna Tehnikaülikoolis : [Tohoku Ülikooli biomeditsiinielektronika labori juhataja Nozomu Hoshimiya]

Min, Mart; Velmre, Enn Mente et Manu 2001 / lk. 3 : portr https://www.ester.ee/record=b1242496*est

Jõupooljuhtseadiste numbrilise modelleerimise alased tööd TPI-s

Velmre, Enn Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis 1988 / lk. 128-143

Jõupooljuhtseadiste numbriliste mudelite väljatöötamine ja rakendamine : ainevaldkond : elektrotehnika : magistritöö

Udal, Andres 1992 http://www.ester.ee/record=b2630327*est

Kui vana on elektroonika?

Velmre, Enn Elektroonika 2004 : XI rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva materjalid 2004 / lk. 53-56

Kui vana on elektroonika? : ettekanne rahvusvahelise telekommunikatsioonipäeva konverentsil "Elektroonika 2004" 14. mail 2004 TTÜs

Velmre, Enn Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2004 2005 / lk. 291-296

Kuulsa füüsiku mälestusmärk TTÜ linnakus : [Thomas Johann Seebecki mälestusmärgi avamine 24. mail]

Velmre, Enn Mente et Manu 2013 / lk. 18 : fot https://www.ester.ee/record=b1242496*est

Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis

Kulbach, Valdek; Hinrikus, Hiie; Järvik, Jaan; Kanasaar, Eduard; Kilk, Aleksander; Metusala, Tiit; Mägi, Vahur; Tamm, Uljas; Tapupere, Olev; Tiismus, Hugo; Ubar, Raimund-Johannes; Velmre, Enn 1988 https://www.ester.ee/record=b1243393*est

Laterally pumped GaAs/AlGaAs quantum wells as sources of broadband terahertz radiation

Reeder, Reeno; Ikonic, Zoran; Harrison, Paul; Udal, Andres; Velmre, Enn Journal of applied physics 2007 / 7, [6] p. : ill
<https://pubs.aip.org/aip/jap/article/102/7/073715/987937/Laterally-pumped-GaAs-AlGaAs-quantum-wells-as>

Measurement of charge carrier lifetime temperature dependence in 4H-SiC power diodes

Velmre, Enn; Udal, Andres Abstracts of International Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ICSCRM'99 : October 10-15, 1999, Research Triangle Park, North-Carolina, USA 1999 / paper no 394, 2 p
https://www.researchgate.net/publication/240833834_Measurement_of_Charge_Carrier_Lifetime_Temperature-Dependence_in_4H-SiC_Power_Diodes

Measurement of charge carrier lifetime temperature-dependence in 4H-SiC power diodes

Udal, Andres; Velmre, Enn Proceedings of the International Conference on Silicon Carbide and Related Materials - 1999 (ICSCRM'99) : Research Triangle Park, North-Carolina, USA, Oct. 10-15, 1999. Vol. 1 2000 / p. 781-784
<https://www.scientific.net/MSF.338-342.781>

Modeling and simulation of bipolar semiconductor devices : authors's main publications

Velmre, Enn 1996 http://www.ester.ee/record=b2079366*est

Modeling in semiconductor electronics

Velmre, Enn; Rang, Toomas BEC : Baltic Electronics Conference : proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 2 1994 / p. 501-516: ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Modeling in semiconductor electronics

Javor, A.; Rang, Toomas; Szekely, V.; Tarnay, K.; Velmre, Enn 1993 https://www.ester.ee/record=b1031052*est

Modeling of a carbon nanotube junction with ab-initio software VASP

Velme, Enn; Klopov, Mihhail; Udal, Andres BEC 2008 : 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology : October 6-8, 2008, Tallinn, Estonia 2008 / p. 75-78 : ill

Modeling of charge carrier non-isothermal transport parameters in silicon

Velme, Enn; Udal, Andres BEC'98 : the 6th Biennial Conference on Electronics and Microsystems Technology, October 7-9, 1998, Tallinn, Estonia : proceedings 1998 / p. 71-74: ill

Modeling of lattice heat conductivity and thermopower in SiC considering the four-phonon scattering processes

Velme, Enn; Udal, Andres Material science forum 2003 / p. 391-394 <https://www.scientific.net/MSF.433-436.391>

Modeling of photon recycling in GaN-devices

Velme, Enn; Udal, Andres; Klopov, Mihhail Material Science Forum. 483/485 2005 / p. 1039-1042
https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices

Modeling of photon recycling in GaN-devices

Velme, Enn; Udal, Andres; Klopov, Mihhail 5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : book of abstracts : 31 August-4 September 2004, Bologna, Italy 2004 / p. 317-318
https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices

Modeling of photon recycling in GaN-devices

Velme, Enn; Udal, Andres; Klopov, Mihhail Silicon carbide and related materials 2004 : ECSCRM 2004 : proceedings of the 5th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, August 31-September 4, 2004, Bologna, Italy 2005 / p. 1039-1042 : ill https://www.researchgate.net/publication/250344144_Modeling_of_Photon_Recycling_in_GaN-Devices

Modelling of charge carrier non-isothermal transport in silicon and silicon carbide

Velme, Enn; Udal, Andres Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2000 / p. 144-154 : ill
https://artiklid.elnet.ee/record=b1004044*est

Nanotehnoloogiad : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms

2011 https://www.ester.ee/record=b2707940*est

Nanotehnoloogiad : sõnastik. Osa 3, Süsinik-nanoobjektid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 3, Carbon nano-objects

2011 https://www.ester.ee/record=b2707947*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms (ISO/TS 80004-1:2010)

2015 http://www.ester.ee/record=b4454097*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 1, Tuumik-sõnavara = Nanotechnologies : vocabulary. Part 1, Core terms (ISO/TS 80004-1:2015)

2016 http://www.ester.ee/record=b4601747*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 3, Süsinik-nanoobjektid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 3, Carbon nano-objects (ISO/TS 80004-3:2010)

2015 http://www.ester.ee/record=b4454176*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 4, Nanostruktuur-materjalid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 4, Nanostructured materials (ISO/TS 80004-4:2011)

2015 http://www.ester.ee/record=b4454176*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 6, Nanoobjektide karakteriseerimine = Nanotechnologies : vocabulary. Part 6, Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)

2015 http://www.ester.ee/record=b4457416*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 6, Nanoobjektide karakteriseerimine = Nanotechnologies : vocabulary. Part 6, Nano-object characterization (ISO/TS 80004-6:2013)

2015 http://www.ester.ee/record=b4483533*est

Nanotehnoloogiad [Võrguteavik] : sõnastik. Osa 8, Nanootootmisprotsessid = Nanotechnologies : vocabulary. Part 8, Nanomanufacturing processes (ISO/TS 80004-8:2013)

2015 http://www.ester.ee/record=b4531230*est

Nanotehnoloogiat meilt ja mujalt

Velmre, Enn Elektriala 2005 / 6, lk. 22-24 : ill

Nonisothermal numerical simulation of semiconductor power devices

Velmre, Enn; Udal, Andres Automation, simulation & measurement : ASM'91 : 3rd biennial conference, Tallinn, October 7-11, 1991. Section S / Tallinn Technical University 1992 / p. 139-145: ill

Numerical analysis of forward-biased diode structures based on direct-gap semiconductors

Velmre, Enn; Freidin, Boris Electronics letters : an international publication 1979 / p. 383-385

https://www.ester.ee/record=b2180432*est

Numerical analysis of the on-state of diode structures based on direct-gap semiconductors

Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres Physica scripta : an international journal for experimental and theoretical physics 1981 / p. 468-471 : ill https://www.ester.ee/record=b2244094*est <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0031-8949/24/2/026/pdf>

Numerical aspects of the development of quantum cascade laser simulation software

Reeder, Reeno; Udal, Andres; Velmre, Enn; Valavanis, Alexander BEC 2014 : 2014 14th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 14th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 6-8, 2014, Tallinn, Estonia 2014 / p. 37-40 : ill

Numerical investigation of digitised parabolic quantum wells for terahertz AlGaAs/GaAs structures

Reeder, Reeno; Udal, Andres; Velmre, Enn; Harrison, Paul BEC 2006 : 2006 International Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 2-4, 2006, Tallinn, Estonia : proceedings of the 10th Biennial Baltic Electronics Conference 2006 / p. 51-54 : ill

Numerical investigation of SiC devices performance considering the incomplete dopant ionization

Velmre, Enn; Udal, Andres Silicon carbide and related materials 2005 2006 / p. 1383-1386 <https://www.scientific.net/MSF.527-529.1383>

Numerical modeling of the electrothermal transient process in diode structures based on direct-gap semiconductors

Velmre, Enn; Freidin, Boris Physica status solidi. A, Applied research 1983 / p. K131-K134 https://www.ester.ee/record=b1562026*est

Numerical simulation of a forward-based p-i-n structure with band-to-band Auger recombination

Freidin, Boris; Velmre, Enn Electronics letters : an international publication 1978 / p. 701-703

https://www.ester.ee/record=b2180432*est

Numerical simulation of a silicon carbide diode

Velmre, Enn; Udal, Andres BEC : Baltic Electronics Conference : proceedings of the 4th Biennial Conference, October 9-14, 1994, Tallinn (Estonia). 2 1994 / p. 559-566: ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Numerical simulation of electrothermal effects in ESD protection devices

Hellstrom, S.; Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres Techn. Dig. of the 3rd European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis, 1992, Oct. 5-8, Schwäbisch Gmünd, Germany 1992 / p. 77-80 <https://d-nb.info/921228503/04>

Numerical simulation of electrothermal interactions in semiconductor devices experiencing ESD pulses

Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres Techn. Dig. of International Workshop on Computational Electronics, 1992 May 28-29, Beckman Institute, Univ. of Illinois Urbana-Champaign, USA 1992 / p. 75-78 : ill https://in4.iue.tuwien.ac.at/pdfs/iwce/iwce1_1992/pdfs/pp075-078.pdf

Pooljuhid läbi aegade

Velmre, Enn Horisont 1974 / lk. 15-19 : ill.; 7 lk. 26-28 : ill.; 9 lk. 24-27 <https://www.digar.ee/arhiiv/et/periodika/69737>

<https://www.digar.ee/arhiiv/et/periodika/69744> https://www.ester.ee/record=b1072243*est <https://www.digar.ee/arhiiv/et/periodika/69745>

Power diode transient characteristics modeling in inductive load circuits

Freidin, Boris; Velmre, Enn; Udal, Andres The Bug Exterminator (USA) 1991 / 3, p. 1-5: fig

Quantum mechanical transforms between x- and k-space as a signal processing problem

Udal, Andres; Kukk, Vello; Velmre, Enn; Klopov, Mihhail BEC 2008 : 2008 International Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 11th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology : October 6-8, 2008, Tallinn, Estonia 2008 / p. 71-74 : ill https://www.ester.ee/record=b2150914*est

Raamatu tekkeloost

Velmre, Enn Elektriala 2022 / lk. 27 https://www.ester.ee/record=b1240496*est

Saateks

Velmre, Enn Tallinna kaupmehepojast füüsikaklassikuks : Thomas Johann Seebeck 1770-1831 2022 / lk. 13-17

https://www.ester.ee/record=b5519213*est

SiC-diodes forward surge current failure mechanisms : experiment and simulation

Udal, Andres; Velmre, Enn Microelectronics reliability 1997 / p. 1671-1674 [https://doi.org/10.1016/S0026-2714\(97\)00136-4](https://doi.org/10.1016/S0026-2714(97)00136-4)

SiC-diodes forward surge current failure mechanisms : experiment and simulation

Velmre, Enn; Udal, Andres ESREF'97 : proceedings of the 8th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis, Oct. 7-10, 1997, Bordeaux, France 1997 / p. 1671-1674
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026271497001364>

Study of radiative recombination influence in GaN and GaAs bipolar transistor structures

Velmre, Enn; Udal, Andres; Verbitski, Irina BEC 2004 : proceedings of the 9th Biennial Baltic Electronics Conference : October 3-6, 2004, Tallinn, Estonia 2004 / p. 59-62 : ill

Tallinna kaupmehe pojast füüsikaklassikuks. Thomas Johann Seebeck (1770-1831)

Velmre, Enn Vana Tallinn. XXIII (XXVII) 2012 / lk. 274-286 : ill

Tallinna kaupmehepojast füüsikaklassikuks : Thomas Johann Seebeck 1770-1831

Velmre, Enn 2022 https://www.ester.ee/record=b5519213*est

TEA entsüklopeedia

2012 https://www.ester.ee/record=b2869027*est

TEA entsüklopeedia

2011 https://www.ester.ee/record=b2666688*est

TEA entsüklopeedia

2011 https://www.ester.ee/record=b2712813*est

Termoelektri avastaja Thomas Johann Seebeck : [ettekanne rahvusvahelisel seminaril 11. mail 2007 TTÜs]

Velmre, Enn Tallinna Tehnikaülikooli aastaraamat 2007 2008 / lk. 335-339

A theoretical study of electron drift mobility anisotropy in n-type 4H- and 6H-SiC

Velmre, Enn; Udal, Andres Materials science forum 2000 / p. 725-728

A theoretical study of electron drift mobility anisotropy in n-type 4H- and 6H-SiC

Velmre, Enn; Udal, Andres Abstracts of International Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ICSCRM'99 : October 10-15, 1999, Research Triangle Park, North-Carolina, USA 1999 / paper no 395, 2 p
https://www.researchgate.net/publication/250338907_A_Theoretical_Study_of_Electron_Drift_Mobility_Anisotropy_in_n-Type_4H-and_6H-SiC

A theoretically accurate mobility model for drift-diffusion power device simulation

Velmre, Enn; Udal, Andres; Kocsis, T.; Masszi, F. 16th Nordic Semiconductor Meeting, Laugarvatn, Iceland, June 12-15, 1994 : abstracts 1994 / p. 92

Thermopower measurements in 4H-SiC and Theoretical calculations considering the phonon drag effect

Grivickas, V.; Stölzer, M.; **Velmre, Enn; Udal, Andres**; Grivickas, P.; Syväjärvi, M.; Yakimova, R.; Bikbajevs, V. Abstracts of the 3rd European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : ECSCRM'2000 : Sept. 3-7, 2000, Kloster Banz, Germany 2000 / p. 144

Thermopower measurements in 4H-SiC and theoretical calculations considering the phonon drag effect

Grivickas, V.; Stölzer, M.; **Velmre, Enn; Udal, Andres**; Grivickas, P.; Syväjärvi, M.; Yakimova, R.; Bikbajevs, V. Silicon Carbide and Related Materials : ECSCRM2000 : proceedings of the 3rd European Conference on Silicon Carbide and Related Materials : Kloster Banz, Germany, September 2000 2001 / p. 491-494 : ill
https://www.researchgate.net/publication/240833914_Thermopower_Measurements_in_4H-SiC_and_Theoretical_Calculations_Considering_the_Phonon_Drag_Effect

Thomas J. Seebeck 250 : tänased mikro- ja nanoelektronika lahendused toetuvad tuntumaile Eestis sündinud täppisteadlasele

Härmat, Karin Mente et Manu 2020 / lk. 64-65 : ill https://www.ttu.ee/public/m/mente-et-manu/MM_01_2020/mobile/index.html
https://www.ester.ee/record=b1242496*est

Thomas J. Seebeck 250 : tänased mikro- ja nanoelektronika lahendused toetuvad tuntumaile Eestis sündinud täppisteadlasele

Härmat, Karin Elektriala 2020 / lk. 24-25 http://www.ester.ee/record=b1240496*est

Thomas Johann Seebeck (1770-1831)

2007 http://www.ester.ee/record=b2285820*est

Thomas Johann Seebeck (1770-1831)

Velmre, Enn Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Engineering 2007 / 4, p. 276-282

Thomas Johann Seebeck and his contribution to the modern science and technology

Velmre, Enn BEC 2010 : 2010 12th Biennial Baltic Electronics Conference : proceedings of the 12th Biennial Baltic Electronics Conference : Tallinn University of Technology, October 4-6, 2010, Tallinn, Estonia 2010 / p. 17-24 : ill

Thomas Johann Seebeck ja tema panus tänapäeva teadusesse ja tehnikasse

Velmre, Enn Elektriala 2019 / lk. 28-29 : ill; 4, lk. 28-29 : ill; 5, lk. 26-27 : fot http://www.ester.ee/record=b1240496*est

Tunne kolleegi. Enn Velmre : [intervjuu Enn Velmrega]

Velmre, Enn; Rang, Toomas; Haldre, Eero; Oras, Anne; Min, Mart Avaja 2003 / lk. 3 : fot

Two-dimensional surge current modeling of packaged power devices

Udal, Andres; Freidin, Boris; Velmre, Enn The Bug Exterminator : a monthly publication of Silvaco International 1992 / 12, p. 6-7

Tööstuselektronika eriala üliõpilaste ankeetvaatluse tulemustest

Velmre, Enn Õppemetoodika küsimusi : 13 1976 / lk. 72-74 https://www.ester.ee/record=b1346720*est

Uuringuid jõupooljuhtelektroonika seadiste ja seadmete alalt

Velmre, Enn Tehnikauuringute areng Eesti NSV-s : vabariikliku konverentsi ettekannete teesid Tallinn, 15.-16. oktoober 1986 1986 / lk. 129-132 https://www.ester.ee/record=b1258828*est

Аналитико-численная модель для исследования стационарного непроводящего состояния силовых тиристорov

Velmre, Enn; Rang, Toomas Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 57-67 : ил

https://www.ester.ee/record=b1288985*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4e3815a3-f217-4ae2-9776-1b5ea3c25959>

Влияние распределения примеси на прямую ВАХ арсенидгаллиевых силовых диодных структур

Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 32-37

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Гармоническая линеаризация широтно-импульсного модулятора второго рода

Velmre, Enn Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с. 135-143 : илл

https://www.ester.ee/record=b2190624*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996>

Зависимость подвижности электронов и дырок от температуры и концентрации примеси в кремнии

Rang, Toomas; Velmre, Enn Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 115-120 : ил

https://www.ester.ee/record=b2190987*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200>

Измерение коэффициентов ударной ионизации в рп-переходах при очень низкой интенсивности размножения

Velmre, Enn; Pikkov, Mihhail Машинное проектирование электронных устройств и систем 1989 / с. 3-19 : ил

Использование четырехзондового метода для измерения различных параметров полупроводникового материала

Samolevski, B.; Korpen, J.; Velmre, Enn XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 117 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Исследование лавинного пробоя р-п перехода

Rang, G.; Velmre, Enn XX студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР : тезисы докладов. Часть 1 1974 / с. 118 https://www.ester.ee/record=b1306141*est

https://www.ester.ee/record=b1306141*est

Исследование процесса переключения диодных структур низковольтных диодов с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; Velmre, Enn; Lumi, J.; Tarma, Mati; Udal, Andres Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 13-17

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ВАХ мощных диодов с узкой базовой областью

Vaher, G.; Velmre, Enn; Tarma, Mati Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 9-12

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ветви вольтамперной характеристики эпитаксиальных и диффузионных электросварочных диодов

Vaher, G.; Velmre, Enn; Mäe, T.; Freidin, Boris Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 7-15

https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Исследование устойчивости установившегося режима в системе с широтно-импульсной модуляцией второго рода

Velmr, Enn Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 12 1974 / с. 51-62 : ил

https://www.ester.ee/record=b2190668*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/57b94a1f-6879-4443-b6f2-322fd7e53d89>

Исследование эффективности численных алгоритмов моделирования силовых полупроводниковых структур в проводящем состоянии

Velmr, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1981 / с. 85-88 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

К вопросу об эффективной длине диффузии носителей заряда в условиях перепоглощения рекомбинационного излучения

Velmr, Enn Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 32-33 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

К расчету максимального напряжения переключения р-п-р-структуры

Velmr, Enn; Rang, Toomas Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 121-126 : ил https://www.ester.ee/record=b2190987*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200>

К расчету некоторых параметров процесса лавинного размножения носителей в резких кремниевых р-п-переходах

Vaher, G.; Velmr, Enn Применение эпитаксиальной технологии в производстве силовых полупроводниковых приборов : сборник материалов Всесоюзного научно-технического семинара. Часть 1 1978 / с. 89-96 https://www.ester.ee/record=b1273235*est

К расчету отпирающего тока управления р-п-р-структуры

Nurste, Ivar; Velmr, Enn Анализ и моделирование технических устройств и систем АСУТП 1977 / с. 127-133 : ил https://www.ester.ee/record=b2190987*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b7c66054-0b4f-4684-9453-442bc7e6e200>

Лавинное размножение носителей в кремниевых арсенид-галлиевых и фосфидиндиевых дополнительных РН-переходах

Rang, Toomas; Velmr, Enn Расчет и проектирование систем технической кибернетики 1984 / с. 3-13

Лавинное размножение носителей заряда в дополнительных р-п-переходах

Velmr, Enn Расчет и проектирование приборов, устройств и систем технической кибернетики 1981 / с. 3-14 : ил https://www.ester.ee/record=b1319172*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4c9b1559-97b9-4d9b-bac8-6c40840ba442>

Моделирование технологического процесса кремниевых силовых полупроводниковых приборов на ЭВМ

Rang, Toomas; Velmr, Enn Синтез и диагностика цифровых устройств и систем 1982 / с. 107-112 : ил https://www.ester.ee/record=b1328194*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/febd586e-d7fa-4fbd-bf41-40576a75f94b>

Неизотермическая динамическая прямая ветвь вольт-амперной характеристики силовых арсенид-галлиевых диодов

Aškinazi, German; Velmr, Enn; Logussov, A.; Timofeev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V. Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / с. 48-56 https://www.ester.ee/record=b1264310*est

О влиянии Оже-рекомбинации на прямую ветвь вольтамперной характеристики силового полупроводникового диода

Velmr, Enn; Dorodnev, V. Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 13 1975 / с. 85-91 : ил https://www.ester.ee/record=b2190710*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ffbd63ed-06d6-4bbb-9468-118f743cc87f>

О влиянии электронно-упрочного рассеяния на коэффициент передачи лико микроэлектронного биполярного транзистора

Velmr, Enn; Udal, Andres Математическое моделирование физических процессов в полупроводниках и полупроводниковых приборах : тезисы докладов II всесоюзного совещания (г. Ярославль, сентябрь 1988 г.) 1988 / с. 40

О развитии научно-исследовательского направления "Приборы и устройства силовой полупроводниковой электроники"

Velmr, Enn Развитие научных исследований в области технических наук в Эстонской ССР : тезисы республиканской конференции, Таллин, 15-16 октября 1986 г. 1986 / с. 136-139 https://www.ester.ee/record=b1231513*est

Обобщенные формулы для анализа лавинного умножения носителей заряда в рп-переходах

Velmr, Enn Automation, simulation & measurement : ASM'91 : 3rd biennial conference, Tallinn, October 7-11, 1991. Section S / Tallinn Technical University 1992 / с. 172-183: ил

Определение параметров рекомбинационных центров из измерений вольт-амперных характеристик р-п-перехода

Velmre, Enn Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной 80-летию со дня изобретения радио А. С. Поповым 1975 / с. 8 https://www.ester.ee/record=b1322122*est

Приближенный метод исследования переноса неравновесных носителей заряда в варизонных полупроводниках с учетом перепоглощения рекомбинационного излучения

Velmre, Enn Полупроводники и гетеропереходы : сборник статей 1987 / с. 12-14 https://www.ester.ee/record=b1262177*est

Приближенный расчет коэффициента переноса носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения

Velmre, Enn Eesti NSV Teaduste Akadeemia toimetised. Füüsika. Matemaatika = Известия Академии наук Эстонской ССР. Физика. Математика = Proceedings of Academy of Sciences of the Estonian SSR. Physics. Mathematics 1984 / lk. 87-94 https://www.ester.ee/record=b1264310*est

Применение интерполяционных кубических сплайнов при решении уравнения диффузии с учетом перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения

Velmre, Enn Расчет и проектирование измерительных преобразователей 1983 / с. 51-55 https://www.ester.ee/record=b1288985*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/4e3815a3-f217-4ae2-9776-1b5ea3c25959>

Применение численных моделей для усовершенствования технологии производства силовых полупроводниковых приборов

Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые методы и технологии микроминиатюрных элементов : Сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

Применение численных моделей при разработке полупроводниковых приборов и технологии их изготовления

Velmre, Enn; Udal, Andres; Freidin, Boris Системы автоматизированного проектирования изделий микроэлектроники, новые методы и технологии микроминиатюрных элементов : Сборник докладов постоянно действующего семинара "Современная технология производства приборов, средств автоматизации и систем управления" 1981 / с. 51-56

Прогнозирование величины ударного тока при одномерном численном моделировании силовых полупроводниковых структур

Velmre, Enn; Nurste, Ivar Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Kõide I 1989 / с. 157-160 : ил https://www.ester.ee/record=b1272248*est

Программа "Динамит-1" для одномерного численного моделирования тиристорных структур

Velmre, Enn; Udal, Andres Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 59-63 : ил https://www.ester.ee/record=b1591355*est

Расчет коэффициента лавинного умножения резких кремниевых р-п-переходов

Velmre, Enn Acta polytechnica. řada 4, Technicko-teoretická = Acta polytechnica. serija 4, Teoretičeskaja = Acta polytechnica. series 4, Theoretical studies = Acta polytechnica. Reihe 4, Theoretische Reihe = Acta polytechnica. série 4, Théorique 1975 / с. 117-122

Расчет коэффициента переноса неосновных носителей заряда в условиях перепоглощения межзонного рекомбинационного излучения

Velmre, Enn Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 25 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Расчет коэффициентов лавинного размножения в резких кремниевых р-п переходах

Vaher, G.; Velmre, Enn Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции, посвященной Дню радио, Таллин, 1977 1977 / с. 49 https://www.ester.ee/record=b1313776*est

Расчет показателя степени в формуле Миллера

Velmre, Enn Труды по электротехнике и автоматике : сборник статей. 11 1973 / с. 145-154 : илл https://www.ester.ee/record=b2190624*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d6e57925-e104-44e1-a218-c5b3110d9996>

Сравнение статических параметров диодных структур из GaAs и InP

Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции "Современные методы и устройства радиоэлектронного оборудования", посвященной Дню радио. Секция: полупроводниковые приборы 1981 / с. 30-31 https://www.ester.ee/record=b1310801*est

Физические аспекты учета влияния эффекта электронно-дырочного рассеяния при математическом

моделировании полупроводниковых структур

Velvre, Enn Машинное проектирование электронных устройств и систем 1988 / с. 166-174 : ил

Численное моделирование напряженности электрического поля и напряжения пробоя в полупроводниковой структуре с двойной фаской

Velvre, Enn; Kuusik, E.; Tergem, Ilmar Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1981 / с. 50-58

https://www.ester.ee/record=b1264428*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах

Velvre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал.

Радиоэлектроника 1984 / с. 86-88 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах при большой плотности прямого тока

Velvre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-

технический журнал. Радиоэлектроника 1989 / с. 80-82 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование неизотермических переходных процессов в силовых полупроводниковых приборах при воздействии мощного импульса прямого тока

Velvre, Enn; Freidin, Boris Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический

журнал 1983 / с. 73-76 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

Численное моделирование переходных процессов в арсенид-галлиевых диодных структурах

Velvre, Enn; Freidin, Boris Известия высших учебных заведений : международный ежемесячный научно-технический журнал.

Радиоэлектроника 1983 / с. 93-95 https://www.ester.ee/record=b2768571*est

Численное моделирование процесса выключения одномерных кремниевых тиристорных структур

Velvre, Enn; Udál, Andres Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 74-79

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование процессов в полупроводниковых структурах с учетом рекомбинации через многозарядные центры

Velvre, Enn; Opštški, A.; Udál, Andres Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы

докладов. Том 1 1987 / с. 131-134 https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Численное моделирование процессов включения и выключения диодной структуры на основе прямозонного полупроводника

Velvre, Enn; Freidin, Boris Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей 1984 / с. 90-94

https://www.ester.ee/record=b1238033*est

Численное моделирование силовых полупроводниковых приборов

Velvre, Enn Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 49-64

Численное моделирование статических неизотермических процессов в кремниевых силовых диодных и тиристорных структурах в открытом состоянии

Velvre, Enn; Udál, Andres; Freidin, Boris Всесоюзный научно-технический семинар "Повышение параметров силовых

полупроводниковых приборов на основе новых конструктивных решений и методов изготовления" (Запорожье, 1981) 1981 / с.37-38

Численное моделирование температурных распределений в кремниевых силовых полупроводниковых приборах при воздействии мощного импульса прямого тока

Velvre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Проблемы моделирования полупроводниковых структур и сложных схем на ЭВМ

1982 / с. 49-58 : ил https://www.ester.ee/record=b1339926*est <https://www.etera.ee/zoom/121726/view?page=3&p=separate&search=true&tool=search>

Численное моделирование тиристора, управляемого полем

Velvre, Enn; Piroženko, Aleksander Численные методы и средства проектирования и испытания элементов твердотельной

электроники : тезисы докладов республиканского совещания. Том I = Tahkekeha elektroonika elementide projekteerimise ja

katsetamise numbrilised meetodid ja vahendid : Vabariikliku nõupidamise ettekannete teesid. Kõide I 1989 / с. 153-156 : ил

https://www.ester.ee/record=b1272248*est

Численное моделирование ударного режима кремниевых тириستоров

Velvre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boriss Измерение и моделирование в электронике 1987 / с. 78-88 : ил

Численное моделирование ударного режима силовых полупроводниковых приборов с учетом электронно-дырочного рассеяния

Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Freidin, Boris Численные методы и средства проектирования и испытания элементов РЭА : тезисы докладов. Том 1 1987 / с. 143-145 : ил https://www.ester.ee/record=b1273986*est

Численное моделирование физических процессов в одномерных кремниевых диодных структурах в стационарном режиме

Velmre, Enn; Freidin, Boris; Udal, Andres Алгоритмы и программы : информационный бюллетень 1980 / с.?

Численное моделирование физических процессов в прямосмещенных структурах на основе прямозонных полупроводников

Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 25-31

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование эксперимента Шокли-Хейнса

Velmre, Enn; Udal, Andres Силовые полупроводниковые приборы : сборник статей 1986 / с. 49-53 : ил

https://www.ester.ee/record=b1591355*est

Численное моделирование электротепловых процессов в силовых полупроводниковых приборах с учетом электронно-дырочного рассеяния

Velmre, Enn; Nurste, Ivar; Seleninov, Kazimir; Freidin, Boris Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей. Часть II 1989 / с. 185-188 https://www.ester.ee/record=b1264433*est

Численное моделирование электрофизических процессов в полупроводниках с учетом электронно-дырочного рассеяния

Velmre, Enn; Piroženko, Aleksander; Udal, Andres Электронное моделирование = Electronic modeling : международный научно-теоретический журнал 1985 / с. 66-71 https://www.ester.ee/record=b1291241*est

Численный анализ неизотермических переходных процессов в арсенидгаллиевых диодных структурах

Aškinazi, German; **Velmre, Enn; Kivi, U.; Timofejev, V.; Freidin, Boris; Šumilin, V.** Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 15 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Численный анализ одномерных полупроводниковых структур в стационарном режиме

Velmre, Enn; Freidin, Boris Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной дню радио и деятельности Эстонской организации НТОРЭС им. А. С. Попова за годы 1958-1978 1978 / с.?

https://www.ester.ee/record=b1314631*est

Численный анализ переходных процессов в диодных структурах на основе прямозонных полупроводников

Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые гетеропереходы : тезисы докладов II республиканской конференции, Эльва 24-26 ноября 1982 г. 1982 / с. 26 https://www.ester.ee/record=b1304403*est

Численный расчет диода с точным учётом электронно-дырочного рассеяния

Velmre, Enn; Udal, Andres Силовые быстродействующие полупроводниковые приборы : сборник статей 1984 / с. 39-43

https://www.ester.ee/record=b1238033*est

Электротехника и автоматика

Mägi, Harri; Velmre, Enn; Pikkov, Mihhail; Orro, S.; Rang, Toomas; Gurjanov, Boris; Kruus, Margus; Salum, Kaja; Berkman, Boriss; Keevallik, Andres; Kasirova, Lilia; Kruus, Margus; Ellervee, Peeter; Ubar, Raimund-Johannes; Grigorjeva, Ksenja; Kont, Toomas 1989 https://www.ester.ee/record=b1285446*est

Электротехника и автоматика

Ubar, Raimund-Johannes; Rang, Toomas; Velmre, Enn; Evarson, Teet; Voolaine, A.; Toome, Tõnis; Viilup, Agu; Sudnitsõn, Aleksander; Berkman, Boriss; Rüstern, Ennu; Leis, Paul; Keevallik, Andres; Kruus, Margus; Jüris, A. 1984

https://www.ester.ee/record=b1549179*est

Электротехника и автоматика

Kukk, Vello; Tamm, Uljas; Pikkov, Otto; Min, Mart; Velmre, Enn; Udal, Andres; Nurste, Ivar; Freidin, Boris; Rang, Toomas; Opotski, Aleksei; Laansoo, Ants; Männama, Vello; Järvalt, Aldur; Gurjanov, Boris; Lavrov, Mihhail; Belkina, I.I.; Plakk, Paul; Plakk, Peeter; Plakk, T. 1987 https://www.ester.ee/record=b1224910*est

Электротехника и автоматика

Rüstern, Ennu; Keevallik, Andres; Kruus, Margus; Salum, Kaja; Berkman, Boriss; Tammemäe, Kalle; Alango, Villem; Kont, Toomas; Ubar, Raimund-Johannes; Lohuaru, Tõnu; Štraube, B.; Elst, G.; Bombik, B.; Viies, Vladimir; Gallai, S.; Rang, Toomas; Laansoo, Ants; Männama, Vello; Pikkov, Otto; Gurjanov, Boris; Opotski, Aleksei; Velmre, Enn 1988

https://www.ester.ee/record=b1256708*est